

ANMELDUNG

„Elektronik am Limit III“ 2014 Symposium zum Thema „Halbleiter“

Faxantwort bitte an Frau Orkide Karasu, +49 (0) 231 / 97 42 - 150

Ich melde mich für die Elektronik am Limit III als Teilnehmer an.

Die Tagungsgebühr beträgt 299,00 € bei Anmeldung bis zum 25.04.2014. Danach beträgt die Tagungsgebühr 329,00 €. Im Preis enthalten sind Pausengetränke und Snacks.

Ich bin IVAM-Mitglied und möchte an der Elektronik am Limit III teilnehmen.

Die Tagungsgebühr beträgt 279,00 € bei Anmeldung bis zum 25.04.2014. Danach beträgt die Tagungsgebühr 309,00 €. Im Preis enthalten sind Pausengetränke und Snacks.

Ich buche einen Platz in der begleitenden Table-Top-Ausstellung.

Die Gebühr beträgt 199,00 €. Im Preis enthalten ist 1 Sitztisch. Die Ausstellung ist auf 10 Teilnehmer begrenzt.

Jedem weiteren Teilnehmer aus demselben Unternehmen gewähren wir eine Vergünstigung von 50 €.

Titel, Vorname, Nachname

Firmenname für die Rechnungsstellung

Rechnungsanschrift

Telefon Fax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. Bei Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung. Bei Absage bis zum 25.04.2014 trotz verbindlicher Anmeldung wird eine Stornogebühr in Höhe von 50,00 € berechnet, danach wird die volle Tagungsgebühr erhoben. Selbstverständlich ist die Nennung eines Ersatzteilnehmers jederzeit und ohne zusätzliche Kosten möglich.

IVAM behält sich vor, während der Veranstaltung Fotomaterial zu produzieren. Dieses Material wird im Rahmen der Pressearbeit, zur Dokumentation und zur Bewerbung zukünftiger Veranstaltungen eingesetzt. Es ist möglich, dass Teilnehmer auf den verwendeten Fotos deutlich erkennbar zu sehen sind. Durch Ihre Anmeldung stimmen Sie der beschriebenen Nutzung zu. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie zu Beginn der Veranstaltung gesondert zu widersprechen. Vielen Dank!

ANFAHRT

TechnologieZentrumDortmund
Emil-Figge-Str. 76 – 80
D-44227 Dortmund

Parkplätze:
Tiefgarage
TechnologieZentrumDortmund
Martin-Schmeißer-Weg

Anreise per PKW

Aus Richtung Norden

A1 bis AK Kamen (Kamener Kreuz), A2 Richtung Oberhausen bis Dortmund-Nordwest. Dann A 45 Richtung Frankfurt bis Dortmund-West. Weiter auf der A40/B1 (weiter siehe aus Richtung Westen und Osten).

Aus Richtung Westen und Osten:

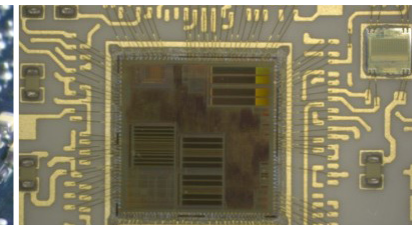
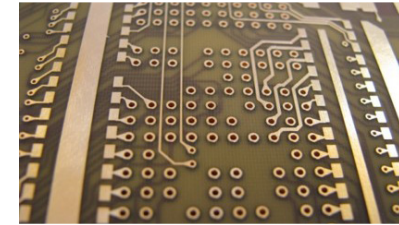
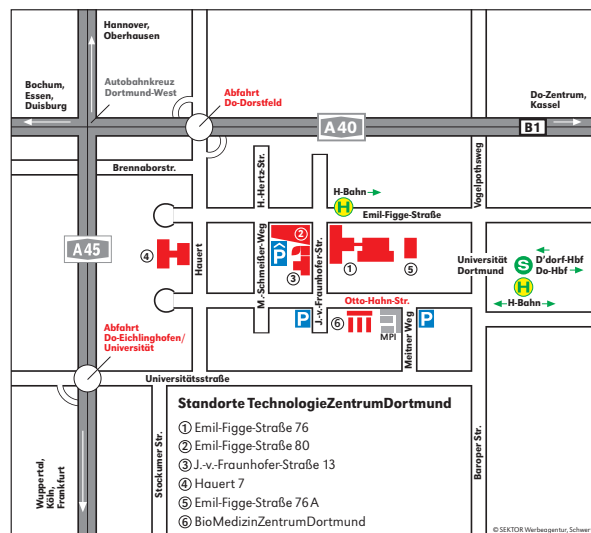
A44/A40/B1 bis zur Abfahrt Dortmund-Dorf/Universität. Rechts in die Wittener Straße und über die nächste Ampelkreuzung geradeaus in den Hauert. Links einordnen und an der nächsten Kreuzung links in die Emil-Figge-Straße. 150 m weiter rechts in den Martin-Schmeißer-Weg und sofort links in die Tiefgarage.

Aus Richtung Süden:

A45 bis Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen/Universität. Rechts in die Universitätsstraße, über die nächste Ampelkreuzung geradeaus. Links einordnen und in den Hauert einbiegen. Geradeaus bis zur zweiten Ampelkreuzung, dann rechts in die Emil-Figge-Straße. 150 m weiter rechts in den Martin-Schmeißer-Weg und links in die Tiefgarage.

Anreise per Bahn

Vom Dortmunder Hauptbahnhof mit der S-Bahn Linie S1 Richtung Solingen, Ausstieg Universität, anschließend mit der H-Bahn zum TechnologieZentrumDortmund.



Quelle: SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

27. MAI 2014,
DORTMUND

ELEKTRONIK AM LIMIT III

Power-Halbleiter „on the edge“

Halbleiter im Hochtemperatur-Einsatz

Strahlungsfeste Halbleiter und hohe Ströme



PROGRAMM

ELEKTRONIK AM LIMIT III - Symposium für - Power-Halbleiter „on the edge“ - Halbleiter im Hochtemperatur-Einsatz - Strahlungsfeste Halbleiter und hohe Ströme

Sehr geehrte Damen und Herren,

Automotive, Aerospace und Medizintechnik: Das sind die Branchen, in denen Höchstbelastungen von Halbleitern an der Tagesordnung sind. Herausforderungen wie Strahlungshärte oder die Fähigkeit sehr hohe Leistungen zu schalten treffen auf immer höhere Ansprüche in der Präzision und Erwartungen an hohe Lebensdauern. Lässt sich all dies vereinbaren?

Zur Diskussion dieser und weitergehender Fragen findet am 27. Mai 2014 in Dortmund das branchenübergreifende Fachforum „Elektronik am Limit III“ statt. Geplant sind Vorträge zu innovativen Themen der Elektronik rund um das Thema Halbleiter, wie beispielsweise der Einsatz von Halbleitern im Weltraum und weltraumnahen Applikationen, Beeinflussung von ICs durch elektromagnetische Strahlung, Schalten von sehr großen Leistungen im Bereich E-mobility, Temperaturanforderungen an Halbleiter, Halbleiter und Ihre EMV-Prüfverfahren oder Lebensdauer und Präzision von Halbleitern unter widrigen Bedingungen.

Hochkarätige Experten aus der Forschung, von Halbleiterherstellern und Prüfeinrichtungen stehen als Referenten zu den genannten Themenkomplexen zur Verfügung, berichten aus ihrer Unternehmenspraxis und teilen ihre Einschätzung der Perspektiven mit.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am 27.05.2014 in Dortmund!



Dr. Olaf Günnewig
SGS INSTITUT FRESENIUS



Dr. Thomas R. Dietrich
IVAM Fachverband für Mikrotechnik

Dienstag, 27. Mai 2014		
Moderation: Markus Ridder, SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Dortmund, DE		
9.00 Uhr	Registrierung der Teilnehmer	
9.30 Uhr	Laborführung	
10.20 Uhr	Begrüßung	Dr. Olaf Günnewig , SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Dr. Thomas R. Dietrich , IVAM Fachverband für Mikrotechnik
<hr/>		
10.30 Uhr	Innovative µC EMV-Prüfverfahren: IC-Scan und Direct Power Injection	Markus Ridder SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Dortmund, DE
11.00 Uhr	Anforderungen an Halbleiter in Defence-, Space- und Aerospace-Anwendungen	Roland Karasch KAMAKA Electronic Bauelemente Vertriebs GmbH, Aalen, DE
11.30 Uhr	Kaffeepause	
<hr/>		
12.00 Uhr	Halbleiter in Umgebungen mit hoher Röntgen- und Gammastrahlung	Dr. Stefan Metzger / Dr. Stefan Höffgen Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich- Technische Trendanalysen INT, Euskirchen, DE
12.30 Uhr	High-Power-Electromagnetics auf Halbleitern	Michael Jöster Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich- Technische Trendanalysen INT, Euskirchen, DE
13.00 Uhr	Mittagspause	
<hr/>		
14.00 Uhr	Design & Manufacturing of High Temperature Semiconductor Components	Pierre Delatte CISSOID S.A., Mont-Saint-Guibert, BE
14.30 Uhr	Mixed Process 150nm SOI for Space and Harsh Environment	Bernard Bancelin Atmel Nantes SAS, Nantes, FR
15.00 Uhr	Kaffeepause	
<hr/>		
15.30 Uhr	Kleine Halbleiter für große Leistungen	Prof. Dr. Felix Hüning Fachhochschule Aachen, Aachen, DE
16:00 Uhr	Challenge of the Usage of COTS in Large Systems Exposed to Radiation	Dr. Markus Brugger CERN EN/STI, Genf, CH
16:30 Uhr	Zusammenfassung und Diskussion	
<hr/>		